4A13 C₆₀ - TTF ドナー - アクセプター系の合成と物性
(筑波大化学系¹・都立大院理²・産総研光技術³) 西川浩之¹, 中村孝弘², 板倉篤 志², 兒玉 健², 菊地耕一², 池本 勲², 近松真之³, 吉田郵司³, 八瀬清志³, 大塩 寛紀¹

【序】ドナーとアクセプターが連結したダイアッド分子は , 有機トランジスターや有機太陽 電池材料への応用の観点から注目を集めている。 我々も C₆₀とπ電子系ドナーである TTF(テ

トラチアフルバレン)誘導体からなる新しいダイアッド(1)を合成し,基底状態においても大きな分子内電荷移動相互作用が存在することをすでに報告している[1]。しかしこの系は成膜性が悪い上,電荷分離状態の寿命が極端に短いためデバイスへの応用には改良が必要である。今回これらの点の克服を目指し,長鎖アルキル基を導入したダイアッドを合成し薄膜化を試みた。また,C₆₀とTTFをデンドリマー構造で連結し,TTFの数を増やしたマルチアッド(G1~G3)の合成を行い,その太陽電池特性を検討したので報告する。



1: $R-R = S(CH_2)_2S$ **2**: $R = SCH_3$ **3**: $R = SC_{12}H_{25}$ **4**: $R = SC_{16}H_{33}$



【長鎖アルキル誘導体】長鎖アルキル基を導入した C₆₀-TTF ダイアッド(3,4)の合成は、すでに報告した方法に従い行った。吸収スペクトルの測定から長鎖アルキル基を導入したダイアッドにおいても、分子内電荷移動吸収帯に対応するブロードな吸収が 700~900 nm に観測され、基底状態において C₆₀と TTF の間に相互作用があることが分かった。化合物 4 を用い

て薄膜の作成を試みた。薄膜 はアモルファスカーボンでコ ーティングした石英基板にキ ャスト法を用いて行った。熱 処理したキャスト膜のX線回 折を測定したところ、回折線 が観測された(図1)。このこ とから、長鎖アルキル基を導 入することにより成膜性が向 上することが分かった。



図 1. 熱処理した4のキャスト膜のX線回折図形

【 C_{60} -**TTF** デンドリマー】 C_{60} - TTF デンドリマー ($G1 \sim G3$)は convergent 法により合成した。シアノエチル基で保護した TTF 誘導体から3段階でデンドロン5とした。つぎに TTF 誘導体を末端に持つポリベンジルエーテル型デンドリマー鎖を構築するため,5 を 3,5-dihydroxybenzylalcohol と反応させ三臭化リンでブロモ化し TTF 二分子導入したデンドロン6へと変換した。同様の操作で TTF 四分子を配したデンドロン7 も合成した。 $G1 \sim G3$ はデンドロン5,6,7 それぞれと C_{60} 誘導体8を用いて合成した。



G1~G3 の吸収スペクトルを図2に示す。500nm および700nm に観測される吸収帯はメタ ノフラーレン構造に由来する吸収である。C₆₀-TTF ダイアッド(1~4)と異なり,700nm より 長波長側に分子内電荷移動帯に対応するような吸収は観測されなかった。このことから,G1 ~G3 においては、基底状態におけるドナー - アクセプター間の相互作用はないものと考えら れる。

図3にG1~G3のサイクリックボルタモグラムを示す。酸化側にはTTF由来の酸化還元波が2波、還元側にはC₆₀部位由来の三段階の可逆な酸化還元波がそれぞれ観測された。また酸化側と還元側のピーク電流値の比はG1で2:1、G2で4:1、G3で8:1にほぼ一致しており、これはデンドリマー中のC₆₀とTTFの分子数比に一致している。還元電位はG1~G3で大きな差は見られなかったが,第一酸化電位はG1,G2で対応するダイアッド2と同程度の大きさでドナー-アクセプター間の相互作用を示唆しているが,G3は約70mV小さく単なるTTF誘導体の酸化電位に近い値であった。



【参考文献】 [1] H. Nishikawa et al., J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 1881-1890.